



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H1357

对应国外型号
2SA1357

主要用途

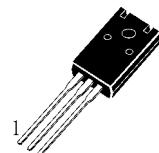
音频功率放大

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散 ($T_a=25^\circ\text{C}$)	1.5W
($T_c=25^\circ\text{C}$)	10W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-35V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-20V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-8V
I_{CP} ——集电极电流(Pulse).....	-8A
I_C ——集电极电流(DC).....	-5A
I_B ——基极电流.....	-1A

外形图及引脚排列

TO-126ML



- 1 发射极，E
- 2 集电极，C
- 3 基 极，B

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-100	nA	$V_{CB}=-35\text{V}$, $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-100	nA	$V_{EB}=-8\text{V}$, $I_C=0$
$V_{(BR)}_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	-20			V	$I_C=-10\text{mA}$, $I_B=0$
$h_{FE(1)}$	直流电流增益(1)	140		600		$V_{CE}=-2\text{V}$, $I_C=-0.5\text{A}$
$h_{FE(2)}$	直流电流增益(2)	70				$V_{CE}=-2\text{V}$, $I_C=-4\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			-1	V	$I_C=-4\text{A}$, $I_B=-0.1\text{A}$
V_{BE}	基极—发射极电压			-1.5	V	$I_C=-4\text{A}$, $V_{CE}=-2\text{V}$
f_T	特征频率		170		MHz	$I_C=-500\text{mA}$, $V_{CE}=-2\text{V}$
C_{ob}	发射极输出电容		62		pF	$V_{CB}=-10\text{V}$, $f=1\text{MHz}$, $I_E=0$

Pulse Test: PW=10Ms(max), Duty Cycle=30%(min)

HFE 分档

Y

GR

BL

HFE (1)

140—240

200—400

300—600



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H1357

对应国外型号
2SA1357

特性曲线

